

第9回 Cat-CVD研究会 プログラム・予稿集目次

6月22日(金)

			ページ
	13:00-13:10	開会(オープニング)	
基調講演		座長: 寺川 朗 (パナソニック)	
<u>OS-01</u>	13:10-13:40	Cat-CVD技術の現状と新しい展開	松村 英樹* (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科)
オールラセッション(I) ~物性評価~		座長: 和泉 亮 (九州工業大学)	
<u>OS-02</u>	13:40-14:20	X線による結晶表面と界面の評価 (招待講演)	原田 仁平* (JPH 研究所(名古屋大学名誉教授))
<u>OS-03</u>	14:20-14:35	水素ラジカルによるPMMA系ポリマーの分解機構の解明 新井 祐*, 能登 雄祐, 渡邊 誠, 鷺見 直也, 高橋 聖司, 河野 昭彦, 石川 健治, 堀 勝, 堀邊 英夫 (金沢工業大学)	
<u>OS-04</u>	14:35-14:50	Cat-CVD a-Si膜の応力制御とフラッシュランプアニールでの結晶化機構への影響 大平 圭介* (北陸先端科学技術大学院大学 グリーンデバイス研究センター)	
<u>OS-05</u>	14:50-15:05	水素ラジカルクリーニング装置におけるラジカルと熱の輸送に関する検討(II) 西山 岩男*, 矢野 容次, 船越 直人, 黒木 裕也, 和泉 亮 (九州工業大学)	
	15:05-15:20	Coffee Break	
オールラセッション(II) ~気相成長~		座長: 大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学)	
<u>OS-06</u>	15:20-16:00	質量分析法を用いた反応性プラズマ中の気相分子計測 (招待講演)	古屋 謙治* (九州大学 基幹教育院)
<u>OS-07</u>	16:00-16:15	ホスフィンの触媒分解で生成するラジカルの検出 梅本 宏信*, 西原 裕心, 石川 卓末 (静岡大学 工学部, JST CREST)	
<u>OS-08</u>	16:15-16:30	リン分子の触媒分解によるリン原子の生成 梅本 宏信*, 黒田 雄貴, 金光 泰二郎 (静岡大学 工学部, JST CREST)	
<u>OS-09</u>	16:30-16:45	Cat-CVD用低価格触媒体のTMA分解と活性化エネルギー 荻田 陽一郎*, 齋藤 直之 (神奈川工科大学 電気電子情報工学科)	
	16:45-16:55	Coffee Break	
オールラセッション(III) ~ニューテクノロジー~		座長: 梅本 宏信 (静岡大学)	
<u>OS-10</u>	16:55-17:35	溶液化学に基づく機能性酸化物集積材料の開発 (招待講演)	加藤 一実* (独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門)
	17:35-17:40	移動(39号館6階→39号館2階) ※移動は階段をご利用下さい(エレベーターは止まりません)	
ナイトセッション ~特別招待講演~		座長: 清水 耕作 (日本大学)	
<u>OS-11</u>	17:40-18:20	Alzheimer's 病と記憶喪失のmechanism (招待講演)	神野 英樹* (日本大学 生産工学部)

6月23日(土)

ページ

- オールセッション(IV) ~新領域~** 座長: 安井 寛治 (長岡技術科学大学)
- OS-12** 9:00-9:40 シリコンNEMSハイブリッド機能デバイス (招待講演) 水田 博*, F. Arab Hassani, M. A. G.-Ramirez, 小木 純, 土屋 良重 (北陸先端科学技術大学院大学, サザンプトン大学)
- OS-13** 9:40-9:55 HW-CVD法を用いた $\mu\text{c-Si:H}/\text{nc-3C-SiC:H}$ 二層膜の膜構造及び電気的特性 渡邊 卓也*, 田畑 彰守 (名古屋大学大学院 工学研究科)
- OS-14** 9:55-10:15 低価格触媒体Cat-CVDによるアルミナ成膜 荻田 陽一郎*, 齋藤 直之 (神奈川工科大学 電気電子情報工学科)
- OS-15** 10:15-10:30 超高速磁気情報センサにむけたCo/Cu磁性薄膜における表面プラズモンの磁気応答 芦澤 好人*, 篠原 周作, 名和田 毅, 中川 活二 (日本大学理工学部)
- 10:30-10:40 Coffee Break
- オールセッション(V) ~プロセス技術~** 座長: 萩田 陽一郎 (神奈川工科大学)
- OS-16** 10:40-11:20 パナソニックの太陽電池技術開発 (招待講演) 寺川 朗* (パナソニック株式会社 次世代エネルギーデバイス開発センター)
- OS-17** 11:20-11:35 SiCN の有機触媒CVD:成長機構の検討 中山 弘*^{1,2}, 伊藤 道弘¹, 福田 常男² (¹(株)マテリアルデザインファクトリー, ²大阪市立大学工学研究科)
- OS-18** 11:35-11:50 Cat-CVD装置を用いたSiへのB原子のドーピング 太田 立教*, 小山 晃一, 大平 圭介, 松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科)
- OS-19** 11:50-12:05 a-Si, SiN_xパッシベーションにおける光劣化 後藤 太樹*, 小山 晃一, 大平 圭介, 松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学 松村研究室)
- 12:05-14:00 ポスター発表(昼食)
- オールセッション(VI) ~新材料・新デバイス~** 座長: 伊藤 貴司 (岐阜大学)
- OS-20** 14:00-14:40 結晶シリコン/有機ハイブリッド太陽電池 (招待講演) 井井 肇*, 上野 啓司 (埼玉大学大学院理工学研究科)
- OS-21** 14:40-14:55 逆位相RF分割電極リモートプラズマ装置による低温Si CVD (依頼講演) 沢田 郁夫, 森嶋 雅人*, 斉藤 幸正 (東京エレクトロン株式会社 技術開発センター)
- OS-22** 14:55-15:10 単層カーボンナノチューブ成長中の自由電子レーザー照射によるカイラリティ制御の解明 津田 悠作*¹, 土肥 智史¹, 岩田 展幸¹, 矢島 博文², 山本 寛¹ (¹日本大学理工学部 電子情報工学科 山本研究室, ²東京理科大学)
- OS-23** 15:10-15:25 Cat-CVD法による単層カーボンナノチューブの面内配向制御 桑山 真*, 相良 拓実, 土肥 智史, 岩田 展幸, 山本 寛 (日本大学理工学部 電子情報工学科)
- 15:25-15:40 Closing

ポスター発表 目次

6月23日(土) 12:05-14:00

ページ

- P-01** ホットワイヤーCVD法により作製したカーボンナノウォールの電気的性質
坂野 允彦*, 中西 庸介, 伊藤 貴紀, 藤井 裕太, 伊藤 貴司, 野々村 修一
(岐阜大学)
- P-02** ロールツーロール型有機触媒CVD 装置の開発
中山 弘*^{1,2}
(¹マテリアルデザインファクトリー, ²大阪市立大学)
- P-03** Cat-CVD SiNx/a-Si積層膜がc-Siに対する 高品質界面特性を有する原因の究明 その2
小山 晃一*, 東嶺 孝一, 大平 圭介, 大塚 信雄, 松村 英樹
(北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科)
- P-04** 表面光電圧法を用いた多結晶シリコン薄膜の結晶性評価
葛生 一馬*, 池田 正則, 清水 博文, 高松 弘行, 迫田 尚和
(日本大学工学部, (株)神戸製鋼所)
- P-05** フリップチップ実装に向けた水素ラジカル洗浄に関する研究 ~HW法およびプラズマ法による水素ラジカル洗浄の比較~
鎌谷 良介*, 太夫本 悟, 野北 寛太, 和泉 亮
(九州工業大学大学院 工学府)
- P-06** HWCVD法による高硬度SiCN膜の堆積条件の検討
河島 慎吾*, 川原 淳樹, 中上 昌俊, 門谷 豊, 山田 知広, 和泉 亮
(九州工業大学大学院 電気電子工学科)
- P-07** FeCl₃を用いたグラファイト及び低層グラフェン層間化合物の作製
市川 博亮*, 佐藤 祥吾, 岩田 展幸, 山本 寛
(日本大学 理工学部 山本・岩田研究室)
- P-08** 太陽電池n-Si用Cat-CVDアルミナパッシベーション膜の短時間熱処理
荻田 陽一郎*, 會澤 洋太郎
(神奈川工科大学 電気電子情報工学科)
- P-09** r面およびc面サファイア基板上でのCr₂O₃薄膜の結晶成長
中村 拓未*, 黒田 卓司, 岩田 展幸, 山本 寛
(日本大学 理工学部 電子情報工学科)
- P-10** パルスレーザー堆積法による鉄系ペロブスカイト酸化物薄膜の作製
及川 貴大*, 土屋 善人, 渡部 雄太, 岩田 展幸, 山本 寛
(日本大学 理工学部)
- P-11** 原子状水素供給スパッタリング法によるシリコン薄膜作製条件の検討
駒崎 洋文*, 清水 耕作
(日本大学大学院 生産工学研究科)
- P-12** シリコンナノ粒子の太陽電池への応用
中村 侑太*, 清水 耕作
(日本大学大学院 生産工学研究科)
- P-13** 酸化物半導体によるpn接合と太陽電池への応用
永井 将司*, 清水 耕作
(日本大学大学院 生産工学研究科)
- P-14** 低電力消費太陽追尾装置の製作と評価
北村 啓*, 清水 耕作
(日本大学大学院 生産工学研究科)
- P-15** Study of the relationship between a gas-barrier property and the residual stress of film made by a Cat-CVD method
堤健智*⁽¹⁾, 天内英隆⁽¹⁾, 柳原英人⁽¹⁾, 吉田重信⁽¹⁾, 大平圭介⁽²⁾, 松村英樹⁽²⁾
(⁽¹⁾三菱樹脂㈱, ⁽²⁾北陸先端科学技術大学院大学)